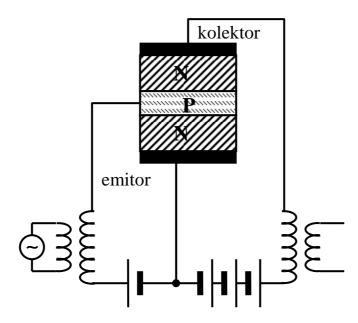
Měření vlastností tranzistoru

Měření charakteristik tranzistoru

Tranzistory jsou polovodičové součástky, které jsou tvořeny dvěma kontakty P-N, přičemž spolu sousedí vždy polovodiče opačného typu vodivosti $(N-\text{negativn}\hat{\textbf{i}},\text{majoritn}\hat{\textbf{i}} \text{nosiče jsou elektrony}, P-\text{pozitivn}\hat{\textbf{i}},\text{majoritn}\hat{\textbf{i}} \text{nosiče jsou díry}). Máme tedy tranzistory PNP (obr. 1) nebo NPN, Jednotlivé elektrody se nazývají emitor <math>(E)$, kolektor (C) a báze (B). V praxi může tranzistor pracovat v různém zapojení, např. se společným emitorem, se společnou bází (obr. 4), nebo se společným kolektorem.



Obr. 1: Schematické znázornění NPN tranzistoru zapojeného se společným emitorem (upraveno podle [1].)

Vlastnosti tranzistoru jsou nejlépe popsány jeho charakteristikami. Uvažujeme-li zapojení tranzistoru se společným emitorem, bude vstupní charakteristika dána závislosti:

$$I_{BE} = f(U_{BE}) \tag{1}$$

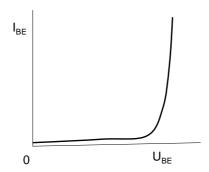
a výstupní charakteristika:

$$I_{CE} = f'(U_{CE}) \tag{2}$$

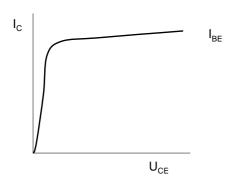
Typický průběh vstupních a výstupních charakteristik je zobrazen na obr. 2 a obr.3. V zapojení se společným emitorem pracuje tranzistor jako zesilovač proudu. Velmi malé kmity napětí, které se překládají přes stejnosměrné napájení v emitorovém obvodu se projeví podobnými kmity v kolektorovém obvodu, kde však budou mít mnohem větší výkon, Zesílení proudu v kolektorovém obvodu je charakterizováno činitelem proudového zesílení α vztahem:

$$\alpha = \left(\frac{\Delta I_{CE}}{\Delta I_{BE}}\right)_{U_{CE} = konst} (U_{CE} = konst)$$
(3)

Pro stanovení proudového činitele zesílení není nutno měřit celé výstupní charakteristiky pro velký počet hodnot proudu bází $I_{\rm BE}$. Pro měření proudového činitele zesílení můžeme použít obvod podle obr. 5. Pro konstantní napětí $U_{\rm CE}$ měříme přímo závislost $I_{\rm CE}$ jako funkce $I_{\rm BE}$. Ze směrnice přímky získané lineární regresí dostaneme proudový zesilovací koeficient α .



Obr. 2: Typický průběh vstupní charakteristiky tranzistoru



Obr. 3: Typický průběh výstupní charakteristiky tranzistoru

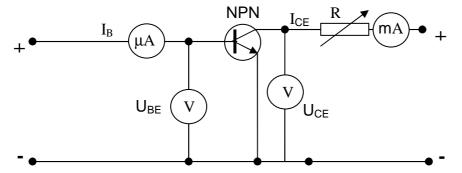
Měření výstupních charakteristik.

Výstupní charakteristika je dána závislostí proudu tekoucího kolektorem I_C (v zapojení podle obr. 5 se společným emitorem je I_C roven proudu mezi kolektorem a emitorem I_{CE}) na napětí mezi kolektorem a emitorem U_{CE} , (rov. 2).

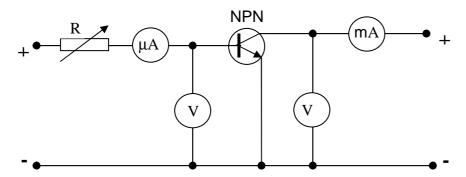
Proměnný odpor R realizujeme např, odporovou dekádou, na které nastavíme odpor řádově $10^4-10^5~\Omega$, Pomocí něho resp, pomocí regulovatelného zdroje nastavíme proud bází $I_{\rm BE}$, Poté regulujeme proud kolektorem $I_{\rm C}$ a měříme napětí $U_{\rm CE}$ voltmetrem s vysokým vstupním odporem, Po proměření jedné charakteristiky změníme proud bází a měření opakujeme. Doplňují informace nalezne čtenář např. v [2].

Pokyny:

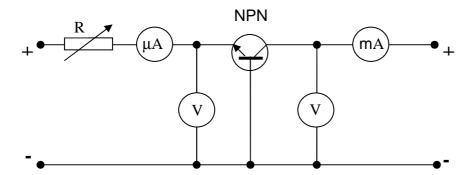
- 1. Pro úkol 1 zapojte obvod podle obr. 4. Proud kolektorem $I_{\rm CE}$ regulujeme odporem R nebo přímo regulovatelným zdrojem. Pro případ nulového proudu odpojíme svorku od zdroje. Napětí mezi kolektorem a emitorem $U_{\rm CE}$ nastavíme 5 V. V obvodu báze emitor měříme pro $U_{\rm BE}$ v intervalu 0-0.8 V.
- 2. Pro úkol 2 zapojte obvod podle obr. 5. Napětí mezi kolektorem a emitorem měňte v intervalu 0-10 V pro proudy bází $0,1,\,0,2$ a 0,3 mA. Odpor R nastavte přibližně $20000~\Omega$.
- 3. Pro úkol 3 použijeme obvod podle obr. 5 a volíme proud bází v intervalu 0,05 0,3 mA. Regulujeme odporem *R* nebo přímo regulovatelným zdrojem.



Obr. 4: Schéma zapojení NPN tranzistoru se společným emitorem pro měření vstupní charakteristiky.



Obr. 5: Schéma zapojení NPN tranzistoru se společným emitorem pro měření výstupní charakteristiky,



Obr. 6: Schéma zapojení NPN tranzistoru se společnou bází

[1] Horák, Z., Krupka, F.: Fyzika, sv. 2, vyd. 2. SNTL, ALFA, 1976

[2] Brož, J.: Základy fyzikálních měření I, vyd. 1. SPN Praha 1967